(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 7 月 28 日(28.07.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/089664 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 23/00 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
H01L 21/301 (2006.01) *H01L 25/065* (2006.01)
H01L 21/683 (2006.01) *H01L 25/07* (2006.01)
H01L 23/29 (2006.01) *H01L 25/18* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/004932

(22) 国際出願日: 2010 年 8 月 5 日(05.08.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2010-010228 2010 年 1 月 20 日(20.01.2010) JP
PCT/JP2010/000810 2010 年 2 月 10 日(10.02.2010) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平野孝(HIRANO, Takashi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 吉田将人(YOSHIDA, Masato) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田７－９－２ 五反田ＴＧビル９階 Tokyo (JP).

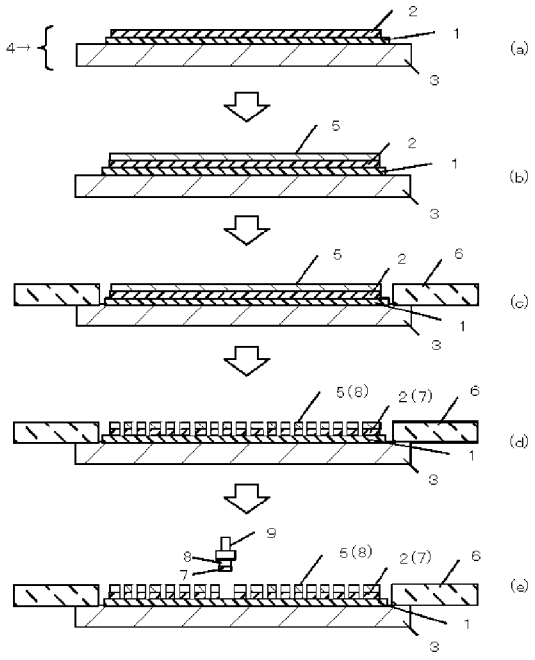
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,

[続葉有]

(54) **Title**: FILM FOR FORMING SEMICONDUCTOR PROTECTION FILM, AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称 : 半導体保護膜形成用フィルム及び半導体装置

[図1]



(57) **Abstract**: Disclosed is a film for forming a semiconductor protection film, which protects a surface, which is on the reverse side of a surface where an outermost semiconductor element is mounted on a structure, such as a substrate. The resin composition configuring the film for forming the semiconductor protection film contains (A) a thermosetting component, and (B) an inorganic filler.

(57) 要約: 本発明は、基板等の構造体に搭載され、かつ最も外側に位置する半導体素子の前記構造体に搭載される面と反対側の面を保護する半導体保護膜形成用フィルムであって、当該半導体保護膜形成用フィルムを構成する樹脂組成物が（Ａ）熱硬化成分及び（Ｂ）無機フィラーを含むことを特徴とする半導体保護膜形成用フィルムである。

WO 2011/089664 A1